

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公開番号】特開2006-100809(P2006-100809A)

【公開日】平成18年4月13日(2006.4.13)

【年通号数】公開・登録公報2006-015

【出願番号】特願2005-249293(P2005-249293)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 1 L 21/20 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 6 2 7 C

H 0 1 L 21/302 1 0 5 A

H 0 1 L 21/302 3 0 1 N

H 0 1 L 29/78 6 2 7 G

H 0 1 L 21/20

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月4日(2008.8.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に半導体膜を形成し、前記半導体膜上に形成される第 1 の酸化物層の一部上に第 2 の酸化物層を形成した後、前記第 1 の酸化物層の露出部を除去し、前記第 2 の酸化物層をマスクとして前記半導体膜をエッチングして、半導体領域を形成し、

前記第 2 の酸化物層は、酸素雰囲気又は空気雰囲気で、透光部及び遮光部を有するマスクを介して前記半導体膜及び前記第 1 の酸化物層にレーザ光を照射して形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

基板上に半導体膜を形成し、前記半導体膜上に形成される第 1 の酸化物層の一部上に第 2 の酸化物層を形成した後、前記第 1 の酸化物層の露出部を除去し、前記第 2 の酸化物層をマスクとして前記半導体膜をエッチングして、半導体領域を形成し、

前記第 2 の酸化物層は、酸素雰囲気又は空気雰囲気で、透光部及び遮光部を有するマスクを介して前記半導体膜及び前記第 1 の酸化物層にレーザ光を照射して形成し、

前記レーザ光の照射によって、前記半導体膜は結晶化されることを特徴とする半導体装置の作製方法。